次世代 EUV 露光装置を備えた最先端半導体の研究開発拠点の整備に関する知事コメント

令和７年１２月１２日（金）

このたび、経済産業省から、産業技術総合研究所が最先端半導体の研究開発拠点を千歳市に整備することについて、発表がありました。

この拠点については、令和７年度当初予算で措置された 318 億円と現在国会審議中の令和７年度補正予算案で計上されている 988 億円の一部を活用して整備を開始すると承知しており、次世代の EUV 露光装置を中核とする半導体の研究開発環境が道内に整備されることは、本道の半導体エコシステムの形成に向けた大きな一歩になると考えています。

今後、Rapidus 社による次世代半導体の量産製造開始やサプライヤーの集積に加え、この拠点の整備により、国内外の半導体メーカー・製造装置メーカー・材料メーカーなどの研究開発がさらに高度化・加速化し、こうした企業の研究開発拠点の道内への立地が進むとともに、道内大学等による利活用により、優秀な半導体人材の育成にもつながるものとして、道の「半導体・デジタル関連産業振興ビジョン」で掲げる半導体の製造、研究、人材育成等が一体となった複合拠点の実現に向けて大きな弾みとなるものと期待しています。

道としては、この拠点整備を心から歓迎するとともに、この拠点を核とした新たなイノベーションの創出を図り、道内の産学官がこれまで進めてきた産業集積や研究開発、人材育成などの取組とも連携しながら、本道経済の活性化と持続的発展につなげてまいります。

北海道知事　鈴木　直道